PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-152547

(43) Date of publication of application: 09.06.1998

(51)Int.CI.

C08G 59/62 C08K 3/22 C08L 63/00 H01L 23/29

H01L 23/29 H01L 23/31 // C08G 14/09

(21)Application number: 08-310851

(71)Applicant: SUMITOMO BAKELITE CO LTD

(22)Date of filing:

21.11.1996

(72)Inventor: IWASAKI SHINICHI

(54) RESIN COMPOSITION FOR SEALING SEMICONDUCTOR

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain the subject composition excellent in frame retardancy, containing neither a halogen nor antimony, by using a specific phenol resin curing agent, etc.

SOLUTION: This composition comprises (A) an epoxy resin, (B) a phenol resin curing agent containing 30–100wt.% of a benzoguanamine modified phenol resin of the formula ((k) is 0–4; (I) and (m) are each $1\le 1+m\le 4$) in the whole phenol resin curing agent, (C) a curing promoter, (D) a metal hydroxide and (E) an inorganic filler. Preferably, the component D is aluminum hydroxide or magnesium hydroxide, has $5-50\mu$ m average particle diameter and $\le 120\mu$ m maximum particle dianieter, the amount of the component D is 3.0-30.0wt.% and that of the component E is 60-90wt.%.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

06.06.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-152547

(43)公開日 平成10年(1998)6月9日

(51) Int.Cl. ⁶		離別記号		FI					
C 0 8 G	59/62			C08G 5	59/62				
C08K	3/22			C08K	3/22				
C08L	63/00			C08L 6	63/00			В	
H01L	23/29			C 0 8 G	14/09				
	23/31			HO1L 2	23/30			R	
			審查請求	未請求 請求	項の数3	OL	(全 4	頁)	最終頁に続く
(21)出願番号		特膜平8-310851		(71) 出願人			イト株式		
(22)出顧日		平成8年(1996)11月21日							5番8号
				(72)発明者	岩崎	慎—			
					東京都	品川区	東品川:	2丁目	5番8号 住友
					ベーク	ライト	株式会社	上内	

(54) 【発明の名称】 半導体封止用樹脂組成物

(57)【要約】

【課題】 ハロゲン系難燃剤及びアンチモンを含まな い、難然性及び耐湿性に優れた半導体封止用樹脂組成物 を得ること。

【解决手段】 (A) エポキシ樹脂、(B) 全フェノー ル樹脂硬化剤中に式(1)のベンゾグアナミン変性フェ

ノール樹脂を30~100重量%含むフェノール樹脂硬 化剤、(C) 硬化促進剤、(D) 金属水酸化物、及び (E) 無機充填材からなることを特徴とする半導体封止 用樹脂組成物。

【化1】

4)

(kは0~4までの整数、1, mは整数で1≦1+m≦

2 化剤、(C)硬化促進剤、(D)金属水酸化物、及び

(E) 無機充填材からなることを特徴とする半導体封止

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A) エポキシ樹脂、(B) 全フェノール樹脂硬化剤中に式(1) のベンゾグアナミン変性フェノール樹脂を30~100重量%含むフェノール樹脂硬

1

$$H \xrightarrow{\text{CH.}} H \xrightarrow{\text{NH}} NH \xrightarrow{\text{NH}} H \xrightarrow{\text{CH.}} H$$

(kは0~4までの整数、1, mは整数で1≦1+m≤ 4)

【請求項2】 金属水酸化物(D)が水酸化アルミニウム又は水酸化マグネシウムで、且つ平均粒径が5~50μm、最大粒径が120μm以下である請求項1記載の半導体封止用樹脂組成物。

【請求項3】 金属水酸化物(D)を全樹脂組成物中に3.0~30.0重量%、無機充填材(E)を全樹脂組成物中に60~90重量%含む請求項1、又は2記載の半導体封止用樹脂組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ハロゲン及びアン チモンを含まない難燃性に優れた半導体封止用樹脂組成 物に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来、ダイオード、トランジスタ、集積 回路等の電子部品は、エポキシ樹脂組成物(以下、樹脂 組成物という)で封止されている。この樹脂組成物中に は、難燃剤としてハロゲン系難燃剤単独、或いはハロゲ ン系難燃剤と三酸化アンチモンとの併用、充填材として 溶融シリカ、結晶シリカ等の無機充填材が配合されてい る。ところが最近では、環境衛生の点から、ハロゲン系 難燃剤、三酸化アンチモン等を使用しない難燃性エポーシ 樹脂組成物が要求されてきている。この要求に対し て、主として難燃剤からのアプローチがなされており、 水酸化アルミニウムや水酸化マグネシウム等の金属水酸 化物、硼素化合物等が検討されているが、これらは、多 量に添加しないと難燃性を発現できないことから、実用 化には至っていない。又、赤燐系の難燃剤は、少量の添

加でも難燃効果があり、樹脂組成物の難燃化に有効であるが、赤燐は微量の水分と反応しホスフィンや腐食性の 燐酸を生じるため、耐湿性に対する要求が厳しい樹脂組 成物には使用できない。このため、赤燐粒子を水酸化ア ルミニウム、金属酸化物、その他の無機化合物、フェノ ール樹脂等の熱硬化性樹脂で被覆し、赤燐の安定化を図 っているが、樹脂組成物に採用できるまでの水準には至 っていない。又、樹脂組成物の主成分であるエポキシ樹 脂、フェノール樹脂等の樹脂成分からの検討も行われて 20 いる。例えば、イミド系樹脂が検討されているが、融点 が高過ぎ流動性に劣るため、採用されるまでには至って いない。

[0003]

用樹脂組成物。

【化1】

【発明が解決しようとする課題】本発明は、このような 問題に対して、ハロゲン及びアンチモンを含まない難燃 性に優れた樹脂組成物を提供するものである。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明は、(A) エポキシ樹脂、(B) 全フェノール樹脂硬化剤中に式(1) の30 ベンソグアナミン変性フェノール樹脂を30~100重量%含むフェノール樹脂硬化剤、(C) 硬化促進剤、

(D) 金属水酸化物、及び(E) 無機充填材からなる半 導体封止用樹脂組成物において、特に、金属水酸化物

(D) として、平均粒径5~50μm、最大粒径120μm以下である水酸化アルミニウム又は水酸化マグネシウムを全樹脂組成物中に3.0~30.0重量%含み、無機充填材(E)を全樹脂組成物中に60~90重量%含むことを特徴とする半導体封止用樹脂組成物である。

【化2】

$$H + \left(\begin{array}{c} \begin{array}{c} \\ \\ \\ \end{array} \right) \\ CH, \begin{array}{c} \\ \\ \\ \end{array} \right) \\ NH + \left(\begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \right) \\ NH + \left(\begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \right) \\ NH + \left(\begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \right) \\ MH + \left(\begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \right) \\$$

(kは0~4までの整数、1, mは整数で1≦1+m≤ 4)

[0005]

【発明の実施の形態】本発明に用いるエポキシ樹脂は、

1分子中にエポキシ基を2個以上有するモノマー、オリ ゴマー、ポリマー全般を言い、その分子量、分子構造を 特に限定するものではないが、例えば、ピスフェノール 50 型エポキシ樹脂、クレゾールノボラック型エポキシ樹 脂、ノボラック型エポキシ樹脂、ピフェニル型エポキシ 化合物、スチルベン型エポキシ化合物、トリフェノール メタン型エポキシ化合物、アルキル変性トリフェノール メタン型エポキシ化合物、トリアジン核含有エポキシ樹 脂、テルペン変性エポキシ樹脂等が挙げられ、これらは 単独でも混合して用いてもよい。

【0006】本発明に用いる式(1)のベンゾグアナミン変性フェノール樹脂は、フェノール、ベンゾグアナミン、及びホルムアルデヒドを弱塩基性触媒存在下で反応させたものであり、分子構造中に窒素原子を通常のフェノールノボラック樹脂に比べ多く含んでいるため、、通常のフェノールノボラック樹脂と比較して、燃えにいか増を有している。ベンゾグアナミン変性フェノール樹脂の配合量は、全フェノール樹脂では30~100重量%が好ましい。30重量%未満だとベンブグアナミンの効果が現れず、難燃性が低下する。ここでは、1、mの値は、0≦k≤4、1≦(1+m)≤4が好ましい。kの値が4を越えると、樹脂の粘度が上がり、樹脂組成物の流動性が劣り好ましくない。(1+m)の値が4を越えると、ベンゾグアナミンの効果が薄れ難燃性が低下する。

【0007】式(1)のベンゾグアナミン変性フェノー ル樹脂以外に、他のフェノール樹脂硬化剤を併用する場 合、用いるフェノール樹脂硬化剤は、その分子量、分子 構造を限定するものではないが、例えば、フェノールノ ボラック樹脂、クレゾールノボラック樹脂、ジシクロペ ンタジエン変性フェノール樹脂、キシリレン変性フェノ ール樹脂、テルペン変性フェノール樹脂等が挙げられ、 これらは単独でも混合して用いてもよい。エポキシ樹脂 とフェノール樹脂の配合割合としては、エポキシ樹脂の エポキシ基数とフェノール樹脂硬化剤のフェノール性水 酸基数の比を0.8~1.2とするのが好ましい。

【0008】本発明に用いる硬化促進剤は、エポキシ基とフェノール性水酸基との反応を促進させるものであれば良く、一般に封止用材料に使用されているものをひろく使用することができ、例えば、1,8-ジアザピシクロ(5,4,0)ウンデセンー7、トリフェニルホスフィン、ジメチルベンジルアミン等が挙げられ、これらは単独でも混合して用いてもよい。

【0009】本発明に用いる金属水酸化物としては、水 40酸化アルミニウム又は水酸化マグネシウムが好ましい。又、平均粒径は5~50μmが望ましい。5μm未満だと樹脂組成物の流動性が低下し、50μmを越えると難燃剤の分散性が悪くなり難燃性が低下する。又、最大粒径は120μm以下が好ましい。120μmを越えると、成形時に金型のゲート部を通過できない不具合が生ずる可能性がある。

【0010】本発明に用いる無機充填材としては、例え ト化して樹脂組成物を得た。この樹脂組成物を低圧トラば、溶融シリカ粉末、球状シリカ粉末、結晶シリカ粉 ンスファー成形機 (成形条件:175℃、70kg/c 大、2次凝集シリカ粉末、多孔質シリカ粉末、2次凝集 50 m²、120秒)を用いて成形し、得られた成形品を1

シリカ粉末又は多孔質シリカ粉末を粉砕したシリカ粉末、アルミナ等が挙げらる。配合量は、成形性と信頼性のバランスから、全樹脂組成物中に60~90重量%が望ましい。60重量%未満だと、難燃性が劣り、90重量%を越えると、樹脂組成物の流動性が劣る。

【0011】本発明の樹脂組成物は、(A)~(E)成分の他、必要に応じてシランカップリング剤、カーボンブラック、ベンガラ等の着色剤、天然ワックス、合成ワックス等の離型剤、及びシリコーンオイル、ゴム等の低心力添加剤等の種々の添加剤を適宜配合しても差し支えない。

【0012】又、本発明の樹脂組成物を成形材料として 製造するには、(A)~(E)成分、及びその他の添加 剤をミキサー等を用いて十分に均一混合した後、更に熱 ロール又はニーダー等で溶融混合し、冷却後粉砕して成 形材料とすることができる。これらの樹脂組成物は、電 子部品或いは電気部品の封止、被覆、絶縁等に適用する ことができる。

[0013]

② 【実施例】以下に本発明を実施例で示す。単位は重量部である。

実施例1~6、比較例1~6

オルソクレゾールノボラック型エポキシ樹脂(軟化点6 2℃、エポキシ当量200g/eq)

ビフェニル型エポキシ化合物 (油化シェルエポキシ (株)・製、YX4000H、融点108℃、エポキシ 当量191g/eq)

式 (1) のベンゾグアナミン変性フェノール樹脂 (k = 1、1+m=3、軟化点108℃、水酸基当量234g / a g)

フェノールノボラック樹脂(軟化点80℃、水酸基当**量** 104g/eg)

フェノールアラルキル樹脂(軟化点80℃、水酸基当量 170g/eg)

 8 - ジアザビシクロ(5, 4, 0) ウンデセンー7 (以下、DBUという)

水酸化アルミニウム(平均粒径12μm、最大粒径74 μm)

水酸化マグネシウム (平均粒径18μm、最大粒径90 μm)

溶融シリカ粉末(平均粒径13 μ m、比表面積2.2m $^{2}/_{g}$)

カーボンプラック

カルナバワックス

を表 1 及び表 2 に示したそれぞれの割合でミキサーを用いて常温で混合し、 $70\sim100$ ℃で2 軸ロールを用いて混練し、冷却後粉砕し成形材料とし、これをタブレット化して樹脂組成物を得た。この樹脂組成物を低圧トランスファー成形機(成形条件:175 ℃、70 k g / c m^2 120 秒)を用いて成形し、得られた成形品を1

5

75℃、8時間で後硬化し評価した。結果を表1及び表 2に示す。

【0014】評価方法

- 1. 耐燃性テスト: UL-94垂直テスト (試料厚さ
- 1.0mm)を行い、耐燃性で表した。
- 2. 半田耐湿性テスト:テスト用素子 (16 p S O P)

を85℃、相対湿度85%の環境下で72時間処理し、

その後 260 \mathbb{C} の半田槽に 10 秒間浸漬し、プレッシャークッカーテスト(125 \mathbb{C} 、圧力 2.4 k g / c m^2)を行い、回路のオープン不良の発生時間を測定した

[0015]

【表1】

·	表 1								
	実 施 例								
	1	2	3	4	5	6			
オルソクレソールノボラック型エポキシ樹脂	123	176	40		40				
YX4000H			40	_56	40	50 62			
式(1)(k=1、1+m=3)	139	41	21	20	21	62			
フェノールノボラック樹脂	L	75	21		21				
フェノールアラルキル樹脂			20	36	20				
DBU	3	3	3	3	3	3			
水酸化アルミニウム	30		50	30					
水酸化マグネシウム		100			50	30			
溶融シリカ粉末	700	600	800	850	800	850			
カーボンプラック	2	2	2	2	2	2			
カルナパワックス	3	3	3	3	3	3			
耐燃性	V-0	V-0	V-0	V-0	V-0	V-0			
半田耐湿性(不良発生時間)	300	350	400	300	350	330_			

[0016]

20 【表 2】

	表 2								
	比較例								
	1	2	3	4	5	6_			
オルソクレゾールノボラック型エポキシ樹脂	183	170		36	170				
YX4000H			42	36		88			
式(1)(k=l、l+m=3)	22	21	10	14	211	94			
フェノールノボラック樹脂	87	81			811				
フェノールアラルキル樹脂			30	56		10			
DBU	3	3	<u>.</u> 3	3	3	3			
水酸化アルミニウム	50	201	310	50					
水酸化マグネシウム					20				
溶融シリカ粉末	650	700	600	800	700	800			
カーボンブラック	2	2	2	2	2	2			
カルナパワックス	3	3	3	3	3	3			
耐燃性	V-3	V-1	V-0	V-}	V-1	V-1			
半田耐湿性 (不良発生時間)	300	350	100	350	350	300			

[0017]

【発明の効果】本発明の樹脂組成物を用いると、ハロゲ

ン系難燃剤及び酸化アンチモンを含まない、難燃性及び 耐湿性に優れた半導体装置が得られる。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. ⁶

識別記号

F I

// C08G 14/09